電子励起によるカーボン系物質の構造変化 Structure Changes of Carbon materials induced by Electronic Excitations

目良 裕,前田康二 Yutaka Mera, Koji Maeda

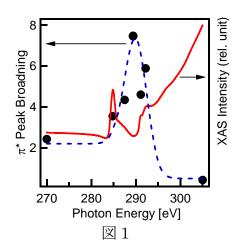
University of Tokyo, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8656, Japan. e-mail: mera@exp.t.u-tokyo.jp

はじめに

本講演では軟X線照射による CNT 中の欠陥生成の実験、及びその機構を探る目的で行った CNT の軟X線誘起イオン脱離の実験について紹介する。

照射による欠陥生成

欠陥の存在はカーボンナノチュー。 (CNT)の物性に大きな影響を与えることが、電子線や極紫外光を照射することがよりで、電子に大路が導入されることが引きたいできた[7]。我々は単層でNT(SWNT)線を照射した。 特に大路では単層でNT(SWNT)線を照射した。 特に大路を開射した内殻電子を協起した。 大塚吸収スペクトル(XAS)に構造と変化を示唆する変化が生じることが出る。 と変化を示唆する変化が生じることが出した。 ので、XASの元*ビーロ射したが生じた。 にブロードニングが生じた。この、照射したがが生じた。 にブロードニングが生じた。 にブロードニングが生じた。 にブロードニングが生じた。 にブロードニングが生じた。 にブロードニングの大きさを数値化して、 に対してプロットしたものが



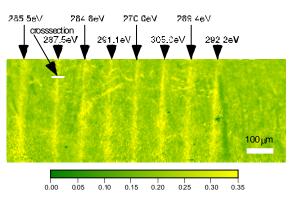


図 2

13C-CNT を用いた照射脱離実験

前節で述べた構造変化あるいは欠陥 生成機構にイオン脱離が関与している かどうかを確かめる目的で、炭素 1s 内 殻励起を起こす軟X線を SWNT に照射す ることにより生じる原子脱離について 調べた。TOF測定の結果、C⁺およびC₉⁺イ オンの脱離は観測されなかった。この 結果は欠陥形成に光エッチングが関与 していないことを示唆するが、COO⁺に比 定可能なイオンの脱離も観測されてお り、この結果だけでは化学吸着分子に よる光エッチングの可能性については 結論できない。そこで ¹³C でエンリッチ したエタノールを原料にアルコール CVD 法で合成した SWNT を試料として用い、 PF-BL13C にて軟X線照射イオン脱離実 験を行った。典型的な TOF スペクトル を図3に示す。測定では13Cを含むと思 われるような脱離分子ピークは観察さ れず、軟X線照射によって単層カーボ ンナノチューブに導入される欠陥は、 チューブを構成する炭素原子の光誘起 エッチングによるものではないことが わかった。

References

- [1] S. Liang, A. Yajima, S. Abe, Y. Mera and K. Maeda, Surf. Sci., 593 (2005) 161.
- [2] S. Liang, Y. Mera, K. Maeda, Diamond and Related Materials, 17 (2008) 137.
- [3] S. Liang, T. Banno, Y. Mera, M. Kitajima, K. Ishioka, Y. Harada, Y. Kitajima, S. Shin and K. Maeda, New Carbon Materials, 23 (2008) 241.
- [4] Y. Nakamura, Y. Mera, K. Maeda, Appl. Phys. Lett., 77 (2000) 2834.
- [5] Y. Nakamura, F. Kagawa, K. Kasai, Y. Mera and K. Maeda, Appl. Phys. Lett., 85 (2004) 5242.
- [6] Y. Mera, M. Yoshino, Y. Nakamura, K. Saishu and K. Maeda, Surf. Sci., 601 (2007) 5207.
- [7] S. Suzuki and Y. Kobayashi, Chem. Phys. Lett., 430 (2006) 370.

